



SLS SEMICONDUCTOR (SHENZHEN) CO.,LTD.

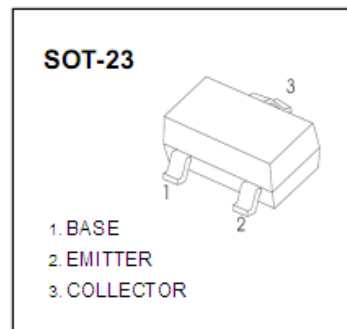
SOT-23 封装半导体晶体管/SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors

MMBT4401 (NPN)

印章/Marking : 2X

用途/Applications :

用于一般开关电路。



极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	V_{CB0}	60	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	V_{CE0}	40	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	V_{EB0}	6	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	I_C	0.6	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	P_C	0.3	W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	375	°C/mW
结温/Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度/Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C

电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	60		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	40		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=100 \mu A, I_C=0$	6		V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=50V, I_E=0$		0.1	μA
集电极发射极穿透电流	I_{CEO}	$V_{CE}=30V, I_B=0$		0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$		0.1	μA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=10V, I_C=150mA$	100	300	
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=150mA, I_B=15mA$		0.4	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=150mA, I_B=15mA$		0.95	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=20mA, f=100MHz$	250		MHz